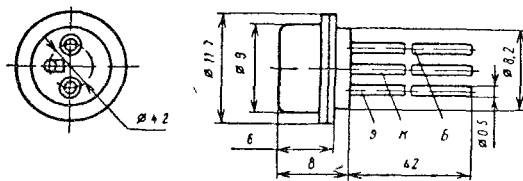


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n*. Предназначены для применения в импульсных и переключающих высокочастотных устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,75 г.

2Т603(А И), КТ603(А-Е)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $U_{КБ}=2$ В:	
2Т603А, 2Т603В, КТ603Д	20..80
КТ603А, КТ603В	10..80
2Т603Б, 2Т603Г	60..180
КТ603Б, КТ603Г, не менее	60
КТ603Е	60..200
при $I_B=350$ мА для 2Т603И, не менее	20
типичное значение	50*
при $T=-60$ °С, $I_B=150$ мА:	
2Т603А, 2Т603В	8..80
2Т603Б, 2Т603Г	20..180
2Т603И, не менее	8
при $T=+125$ °С, $I_B=150$ мА:	
2Т603А, 2Т603В	20..180
2Т603Б, 2Т603Г	60..400
2Т603И, не менее	20

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ

при $U_{КБ}=10$ В, $I_B=30$ мА, не менее	200 МГц
типичное значение	370* МГц

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер:

при $I_K=150$ мА, $I_B=15$ мА:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, не более	0,8 В
типичное значение	0,2* В

КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е,

не более	1 В
при $I_K=350$ мА, $I_B=50$ мА для 2Т603И, не более	1,2 В

Напряжение насыщения база — эмиттер:

при $I_K=150$ мА, $I_B=15$ мА:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е, не более	15 В
типичное значение	0,9* В
при $I_K=350$ мА, $I_B=50$ мА 2Т603И, не более	1,3 В
типичное значение	1* В

Время рассасывания при  $I_K=150$  мА,  $I_B=15$  мА

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, не более	70 нс
типичное значение	40* нс
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е, не более	100 нс

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте

при $U_{КБ}=10$ В, $I_B=30$ мА, $f=5$ МГц, не более	400 пс
типичное значение	25* пс

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ}=10$  В,  $f=5$  МГц,

не более	15 пФ
типичное значение	3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ}=0$ ,  $f=5$  МГц, не

более	40 пФ
типичное значение	35* пФ

Обратный ток коллектора, не более:

при $T=+25$ °С и $U_{КБ0}=30$ В:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	3 мкА
КТ603А, КТ603Б	10 мкА
при $U_{КБ0}=15$ В:	
2Т603В, 2Т603Г	3 мкА
КТ603В, КТ603Г	5 мкА
при $U_{КБ0}=10$ В для КТ603Д, КТ603Е	1 мкА
при $T=+125$ °С и $U_{КБ0}=24$ В для 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	60 мкА
при $U_{КБ0}=12$ В для 2Т603В, 2Т603Г	60 мкА

Обратный ток эмиттера, не более:

при $U_{ЭБ0}=3$ В	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	3 мкА
при $U_{ЭБ0}=4$ В для 2Т603И	3 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — эмиттер при  $R_{сз}=1$  кОм:

$T_n=+70$ °С:	
КТ603А, КТ603Б	30 В
КТ603В, КТ603Г	15 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В
$T_n=+100$ °С:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	30 В
2Т603В, 2Т603Г	15 В
$T_n=+120$ °С:	
КТ603А, КТ603Б	15 В
КТ603В, КТ603Г	7,5 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В
$T_n=+125$ °С:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	24 В
2Т603В, 2Т603Г	12 В

$T_n=+150$  °С

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	18 В
2Т603В, 2Т603Г	9 В

Напряжение эмиттер — база

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г	3 В
2Т603И при $T_n=+70$ °С	4 В
2Т603И при $T_n=+125$ °С	3 В

Постоянный ток коллектора

	300 мА
--	--------

Импульсный ток коллектора при  $t_u \leq 10$  мкс,  $Q=10$

	600 мА
--	--------

Постоянная рассеиваемая мощность:

при $T=+50$ °С	0,5 Вт
при $T=+85$ °С для КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T=+125$ °С для 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И	0,12 Вт

Тепловое сопротивление переход — среда

	200 °С/Вт
--	-----------

Температура *p-n* перехода:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И	+150 °С
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	+120 °С

Температура окружающей среды:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И	-60 .. +125 °С
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	-40 .. +85 °С

Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода транзистора 3 мм.

Не допускается пайка выводов ближе 5 мм от корпуса. Пайку выводов допускается производить не более 10 с при температуре не более +270 °С с теплоотводом между корпусом и местом пайки.

Запрещается кручение выводов вокруг оси.